文章编号: 0253-2239(2008)10-2002-04

基于迭层结构的高效红色有机电致发光器件

辛 琦^{1,2} 李文连² 李天乐² 苏文明² 孙小燕²

1 福州大学物理与信息工程学院,福建 福州 350002

(2)中国科学院长春光学精密机械与物理研究所激发态物理重点实验室,吉林长春 130033

摘要 为了提高红色有机电致发光器件的亮度和效率,引入 Alq₃:Mg/WO₃作连接层制备了红色迭层有机电致发光器件。通过调节 WO₃ 的厚度得到了最佳器件,其效率和亮度达到了普通器件的三倍和四倍。利用铕配合物 [Eu(DBM)₃ bath]和小分子染料器件(DCJTI)单元进行组合制备迭层器件,结构为 ITO/TPD/DCJTI:CBP/BCP/ Alq₃/Alq₃:Mg/WO₃/TPD/Eu(DBM)₃ bath:TPD /Eu(DBM)₃ bath/LiF/Al,器件的最大亮度达 8609 cd/m²,最大 效率达 10.2 cd/A。

关键词 光学器件;有机电致发光器件;迭层结构;连接层;红光

中图分类号 TN383 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS20082810.2002

Highly Efficient Red Organic Light Emitting Diodes Based on Tandem Structure

Xin Qi^{1,2} Li Wenlian² Li Tianle² Su Wenming² Sun Xiaoyan²

¹ College of Physics and Information Engineering, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350002, China ² Key Laboratory of Excited State Processes, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun, Jilin 130033, China

Abstract In order to improve brightness and efficiency of red organic light emitting devices (OLEDs), highly efficient red tandem OLEDs have been fabricated by using $AlQ_3 : Mg/WO_3$ as interconnecting layer. The optimal device whose efficiency and luminance reach three times efficiency and four time of that of a conventional single-unit device respectively, is obtained by controling WO₃ thickness. The device is fabricated by Eu(DBM)₃ bath and DCJTI units, with a structure of ITO/TPD/DCJTI : CBP/BCP/Alq₃/Alq₃ : Mg/WO₃/TPD/Eu (DBM)₃ bath : TPD/Eu (DBM)₃ bath/LiF/Al and the maximum luminance of 8609 cd/m² and the maximum efficiency of 10.2 cd/A are achieved.

Key words optical device; organic light-emitting device (OLED); tandem structure; interconnecting layer; red light

1 引

言

自从 1987 年 C. W. Tang 等^[1] 报道了多层有 机电致发光器件(OLED)以来^[1],OLED 及其相关 特性研究已成为热门研究领域^[2~9],其中绿色 OLED 在效率、亮度和寿命等性能指标上早已达到 了实际应用的需要,而红色 OLED 在亮度和效率上 急需进一步提高。常用于红色 OLED 的发光材料 包括红色荧光小分子染料、红色磷光材料和稀土铕 配合物,它们各有优缺点:荧光小分子染料亮度高, 效率稳定,但总体效率不高;磷光材料效率高,但在 大电流密度下,效率衰减严重^[10];铕配合物具有窄 带发射的特点,有可能应用于三基色全彩显示,但亮 度不高^[11]。L. S. Liao 等^[12,13]发现利用迭层结构 制得的器件在亮度和效率上都有大幅度的提高,并

收稿日期: 2008-01-18; 收到修改稿日期: 2008-05-15

基金项目:国家自然科学基金(90201012)和福建省科技三项项目(2007F50101)资助课题。

作者简介: 辛 琦(1978-),女,博士研究生,讲师,主要从事有机电致发光器件方面的研究。E-mail: yaojm@fzu. edu. cn 导师简介: 李文连(1942-),男,研究员,博士生导师,主要从事有机电致发光器件方面的研究。

把它用于制作绿光和白光器件。本文用迭层结构制 作了红光器件,把红色荧光小分子染料和铕配合物 结合在一起,得到了亮度和效率等各方面性能均十 分出色的 OLED。

2 实 验

销-二苯甲酰甲烷-4,7-二苯基-1,10-菲咯啉配 合物 [Eu (dibenzoylmethane)₃ 4,7-diphenyl-1,10phenanthroline,Eu(DBM)₃bath]是由本实验室合 成的,其他材料则是直接购买的。器件的制作方法 为:在真空度约为 4×10⁻⁴ Pa 的真空腔内,往经过 预处理洁净的 ITO(100/sq)玻璃上依次热蒸发各有 机层和金属电极。发光层和连接层是采用双源共蒸 法制成,器件的发光面积为 2.5 mm×4 mm。电致 发光(EL)光谱由 Hitach-4000 荧光光谱议测得,亮 度-电流-电压特性由北京师范大学研制的电致发光 综合测试系统测得。

3 结果与分析

3.1 DCJTI 迭层器件

4-二氰亚甲基-2-异丙基-6-(1,1,7,7-四甲基久 咯呢定基9烯基)-4H 吡喃[4-(dicyanomethylene)-2-isopropyl-6-(1,1,7,7-tetramethyliulolidyl-9enyl)-4H-pyran,DCJTI]是一种常见的红光小分子 染料,它的发光峰位、发光亮度与其掺杂浓度有很大 的关系,随着浓度的增加其发光峰位出现红移,与此 同时,发光亮度显著下降。首先,制备了 DCJTI 的 普通器件,因为 DCJTI 的发光峰位受其掺杂浓度影 响,调节掺杂浓度使其发光峰位于 620 nm 附近,这样 既能得到色座标比较良好的红光,又能避免发光亮度 过低。当掺杂质量浓度为 2%时,器件的发光峰位正 好处于 620 nm 附近。DCJTI 普通器件结构为:ITO/ TPD (50 nm)/DCJTI: CBP (2%, 30 nm)/BCP (20 nm)/Alq₃(25 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm)。

用连接层 Alq₃: Mg/WO₃把两个独立的 DCJTI 发光单元串联起来制作迭层器件。连接层对迭层器 件至关重要,它会对器件性能的好坏起决定性的作 用,所以先对连接层中 WO₃ 的厚度进行优化。制 作了 WO₃ 厚度分别为1 nm、2 nm、3 nm 和4 nm 的 迭层器件,它们的电流效率-电流密度曲线,如图 1 所示。可见,WO₃ 厚度过厚或过薄都会对器件性能 产生不好的影响,当 WO₃ 厚度为 2 nm 时,器件性 能最佳。最佳 DCJTI 迭层器件结构为:ITO/TPD (50 nm)/DCJTI:CBP (2%, 30 nm)/BCP (20 nm)/ Alq₃(15 nm)/Alq₃:Mg (1:1, 10 nm)/WO₃(2 nm)/ TPD (50 nm)/ DCJTI:CBP (2%, 30 nm)/BCP (20 nm)/Alq₃(25nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm).



图 1 不同 WO₃ 厚度的迭层器件的电流效率-电流密度曲线 Fig. 1 Current efficiency-current density curve for the tandem devices with different WO₃ thickness

表1给出的是 DCJTI 普通器件和迭层器件的各 项性能对比,可见,与普通器件相比,选层器件的亮度 和效率均有了大幅度的提高,其最大亮度达到普通器 件的四倍以上,最大效率也达到普通器件的三倍。而 且效率对电流密度表现出了更高的稳定性,随着电流 密度的增大,效率并没有发生明显的下降。此外,迭 层器件厚度增大,不可避免地带来启亮电压的升高, 但其启亮电压却仍低于普通器件的两倍。

表 1 DCJTI 的普通器件及迭层器件各项性能比较 Table 1 Performance comparison of the DCJTI normal device and the DCITI tandem device

Device	Normal	Tandem
Turn-on voltage /V	6	10.5
Maximum luminance $/(cd/m^2)$	4128	17048
Maximum efficiency /(cd/A)	2.4	7.3
Efficiency (100 mA/cm^2) /(cd/A)	1.3	6.5

DCJTI 迭层器件的亮度和效率均大于普通器件的两倍, 启亮电压则低于普通器件的两倍, 高亮电压则低于普通器件的两倍, 说明迭层器件不仅仅是两个普通器件的简单叠加, 中间的连接层 Alq₃: Mg/WO₃ 对器件性能有显著的提高。和 V₂O₅ 与 NPB 接触时会产生电荷转移复合物 $(V_2O_5^-/NPB^+)$ 一样, WO₃ 也会和与其相邻的 TPD 产生(WO₃⁻/TPD⁺)。电子和空穴将分别落于 WO₃ 与 TPD 上, 然后在外加电场的作用下, 分别注入到相邻的两个发光单元中。也就是 WO₃ 与 TPD 之间的接触界面能使载流子通过它注入到下一个发光单元中, 对迭层器件的性能提高至关重要。此外, J. Kido 等^[14]已证明掺有碱金属或碱土金属的有机层是有效

的电子注入层,G. Parthasarathy 等^[15] 发现在 Mg 和 Alq₃ 之间会发生强的化学相互作用,产生新的离化 态,从而降低电子的注入势垒,提高器件的性能。

3.2 (DCJTI+Eu(DBM)₃bath)迭层器件

DCJTI 迭层器件虽然亮度很高,但由于其本身 效率低,所以尽管它的效率是普通器件的三倍,达到 了 7.4 cd/A,但与绿光器件相比,效率还是偏低。 因此,把 DCJTI 与 Eu(DBM)₃ bath(亮度偏低,但效 率较高)结合起来,制作了迭层器件,器件结构为 ITO/TPD (50 nm)/DCJTI:CBP (2%, 30 nm)/BCP (20 nm)/Alq₃(15 nm)/Alq₃:Mg (1:1, 10 nm)/WO₃ (2 nm)/TPD (50 nm)/Eu(DBM)₃ bath:TPD (2:1, 25 nm)/Eu(DBM)₃ bath (40 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm)。

把(Eu(DBM)₃ bath + DCJTI)迭层器件和 Eu(DBM)₃ bath以及 DCJTI 的普通器件进行性能 对比,Eu(DBM)₃ bath 普通器件的结构为:ITO/ TPD(50 nm)/Eu(DBM)₃ bath:TPD(2:1,25 nm)/ Eu(DBM)₃ bath(40 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 nm)。 比较结果列于表 2。从表 2 可见,选层器件的最大 亮度高达 8609 cd/m²,最大效率为 10.2 cd/A,其亮 度和效率均大于两个普通器件之和,启亮电压则小 于两者之和。因此该迭层器件能同时兼顾到高亮度 和高效率,是一个非常理想的器件。

表 2 DCJTI 普通器件、Eu(DBM)₃ bath 普通器件和迭层 器件各项性能对比

Table 2 Performance comparison of the DCJTI,

Eu(DBM)3 bath normal device and the tandem device

Device	Normal	Normal	
	(DCJTI)	(Eu)	landem
Turn-on voltage /V	6	5	9.5
Maximum luminance $/(cd/m^{2})$	4128	903	8609
Maximum efficiency /(cd/A)	2.4	5.5	10.2
Efficiency (100 mA/cm^2)	1 0	0.9	4 0
/(cd/A)	1.3	0.0	4.0

图 2 给出了(Eu(DBM)₃ bath+DCJTI)迭层器件 的亮度-电压-电流密度(L-V-I)曲线,以及它的电致 发光光谱。可见,器件的电致发光发射峰实际上是由 一个宽峰和一个尖峰重叠在一起形成的,宽峰对应于 DCJTI 的 520 nm 附近的宽带发射,尖峰则来自于 Eu (DBM)₃ bath 中 Eu³⁺ 的 612 nm 处⁵ $D_0 \rightarrow$ ⁷ F_2 特征窄 带发射。器件的发光颜色正好位于红区,亮度为 100 cd/m²和 1000 cd/m² 时器件的 CIE 色坐标分别 为(0.66, 0.33)和(0.65, 0.33)。



图 2 [Eu(DBM)₃ bath+DCJTI]迭层器件的亮度-电压-电流曲线(a)和电致发光光谱(b)

Fig. 2 Luminance-voltage-current characteristics (a) and electra luminescence spectrum (b) of [Eu(DBM)₃ bath+DCJTI]

tandem device

4 结 论

用 Alq₃: Mg/WO₃ 作连接层制备了 DCJTI 迭层 器件,并通过调节 WO₃ 的厚度得到了最佳器件,其效 率和亮度分别达到了普通器件的三和四倍,说明该连 接层对器件性能有明显的提高作用。把 DCJTI 和 Eu (DBM)₃ bath 组合在一起,制成了亮度和效率都非常 出色的迭层器件,最大亮度为 8609 cd/m²,最大效率 为 10.2 cd/A。

参考文献

- C. W. Tang, S. A. Vanslyke. Organic electroluminescent diodes
 [J]. Appl. Phys. Lett., 1987, 51(12): 913~915
- 2 P. E. Burrows, S. R. Forrest, T. X. Zhou *et al.*. Operating lifetime of phosphorescent organic light emitting devices [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2000, **76**(18): 2493~2495
- 3 Lou Shuangling, Yu Junsheng, Li Weizhi et al.. Organic light-emitting devices based on novel hole transport layer[J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(8): 1455~1459 娄双玲,于军胜,黎威志 等. 基于新型空穴传输材料的有机电致发

光器件的研究[J]. 光学学报, 2007, 27(8): 1455~1459

- 4 Zhong Jian, Cheng Jianbo, Chen Wenbin *et al.*. Study on optoelectronic performance of highly bright red doping organic light emitting devices[J]. *Acta Optica Sinica*, 2006, 26(9): 1392~1396
 钟 建,成建波,陈文彬 等. 高亮度掺杂红色有机电致发光器件的 制备与光电性能研究[J]. 光学学报, 2006, 26(9): 1392~1396
- 5 Zhang Xiaobo, Wei Fuxiang, Liu Xiang et al.. Color-coordinate shift in white organic electroluminescent device based on CBP: BCz VB: Btp_2Ir(acac) under large driving currents[J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(3): 487~493

张晓波,委福祥,刘 向等. 基于 CBP: BCzVB: Btp2 Ir(acac)体系的 白色有机电致发光器件色度飘移研究[J]. 光学学报, 2007, 27(3): 487~493

6 Zhou Ying, Geng Yongyou, Gu Donghong. Structure and optical property changes of heat induced NiO_x thin films [J]. Chin. J. Lasers, 2007, $34(1): 123 \sim 128$

周 莹, 耿永友, 顾冬红. 热致 NiO_x 薄膜的结构和光学性质变 化[J]. 中国激光, 2007, **34**(1): 123~128

7 Gu Shaoxuan, Hu Haiping, Guo Haitao. Second-order optical nonlinearity of electrical poling in GeS₂-Ga₂S₃-CdS chalcogenide glass [J]. Chin. J. Lasers, 2006, **33**(5): 687~692 顾少轩,胡海平,郭海涛. GeS₂-Ga₂S₃-CdS 硫系玻璃的电致二阶非

线性光学效应[J]. 中国激光, 2006, **33**(5): 687~692 8 Li Haiyuan, Tang Yongxing. Study on stability of porous silica

antireflective coatings prepared by sol-gel processing dash with organic silica[J]. *Chin. J. Lasers*, 2006, **33**(1): $116 \sim 119$

李海元, 唐永兴. 掺入有机硅提高溶胶-凝胶二氧化硅减反膜的稳

定性研究[J]. 中国激光, 2006, 33(1): 116~119

- 9 Qiu Fengxian, Xu Hongliang, Yang Dongya. Synthesis and research of photochromism based on side-polyimide containing azobenzene group[J]. *Chin. J. Lasers*, 2007, **34**(4): 525~529 邱凤仙,徐红良,杨冬亚. 含偶氮苯侧链型聚酰亚胺的合成及光致 变色性能[J]. 中国激光, 2007, **34**(4): 525~529
- 10 R. C. Kwong, S. Sibley, T. Dubovoy *et al.*. Efficient, saturated red organic light emitting devices based on phosphorescent platinum ([]) porphyrins[J]. *Chem. Mater.*, 1999, **11**: 3709~3713
- 11 C. Adachi, M. A. Baldo, S. R. Forrest. Electroluminescence mechanism in organic light emitting devices employing a europium chelate doped in a wide energy gap bipolar conducting host[J]. J. Appl. Phys., 2000, 87(11): 8049~8055
- 12 L. S. Liao, K. P. Klubek, C. W. Tang. High-efficiency tandem organic light-emitting diodes[J]. Appl. Phys. Lett., 2003, 84(2): 167~169
- 13 C. C. Chang, J. F. Chen, S. W. Hwang *et al.*. Highly efficient white organic electroluminescent devices based on tandem architecture [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2005, 87(25): 253501-1~3
- 14 J. Kido, T. Matsumoto. Bright organic electroluminescent devices having a metal-doped electron-injecting layer[J]. Appl. Phys. Lett., 1998, 73(20): 2866~2868
- 15 G. Parthasarathy, C. Shen, A. Kahn *et al.*. Lithium doping of semiconducting organic charge transport materials [J]. J. Appl. Phys., 2001, 89(9): 4986~4992